

## Технологический обзор

Семейство технологий	Базовая технология	Питание, V		# Me	RF devices	Thick Me	HIPO	MIM	OTP	EEPROM	PDK	Stdcells	I/O	Компилятор RAM	Компилятор ROM	IPs	Статус	Примечание
		core	I/O															
SOI250 КМОП КНИ 0.25 мкм	SOI250_4M_3.3V	3.3	3.3	4	-	-	-	-	-	-	+	+	+	SP	+	+	Освоено	<u>Стойкость к воздействию спец. факторов, обеспечиваемая технологией изготовления и комплектом средств проектирования*</u> :
	SOI250_6M_3.3V	3.3	3.3	6	-	-	+	+	-	-	+	+	+	SP	+	+	Освоено	
SOI180 КМОП КНИ 0.18 мкм	SOI180_6M_1.8V	1.8	1.8	6	-	-	+	+	-	-	+	+	+	SP DP	+	+	Освоено	<u>Стойкость к воздействию спец. факторов, обеспечиваемая технологией изготовления и комплектом средств проектирования*</u> :
	SOI180_6M_3.3V	1.8	3.3	6	-	-	+	+	-	-	+	+	+	SP DP	+	+	Освоено	
	SOI180_6M_5V	1.8	5.0	6	-	-	+	+	+	-	+	+	+	SP DP	+	+	Освоено	
HCMOS8D КМОП 0.18 мкм	HCMOS8D_6M_3.3V	1.8	3.3	6	-	-	+	+	-	-	+	+	+	SP	+	+	Освоено	<u>Допускает применение методологии проектирования Radiation hardening by design</u>
	HCMOS8D_6M_5V	1.8/5.0	3.3	6	-	-	+	+	+	-	+	+	+	SP	+	+	Освоено	
	HCMOS8D_6M_36V	1.8/36	3.3	6	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	Освоение	
CMOSF8 КМОП + ЭСППЗУ 0.18 мкм	CMOSF8_4M_5V	1.8	5.0	4	-	-	-	-	-	+	+	+	+	SP	+	+	Освоено	
	CMOSF8_6M_5V	1.8	5.0	6	-	+	+	+	-	+	+	+	+	SP	+	+	Освоено	
HCMOS10_LP КМОП 0.09 мкм	HCMOS10_LP_7M_2.5V	1.2	2.5	7	+	+	+	+	-	-	+	+	+	SP DP SP_RHBD DP_RHBD	+	+	Освоено	<u>Допускает применение методологии проектирования Radiation hardening by design</u>
	HCMOS10_LP_7M_3.3V	1.2	3.3	7	-	+	+	+	-	-	+	+	+	SP DP SP_RHBD DP_RHBD	+	-	Освоение	
SOI090 КМОП КНИ 0.09 мкм	КНИ90_7M_3.3B	1.2	3.3	7	-	+	+	+	-	-	+	+	+	SP DP	+	+	Освоено	

\* стойкость достигается использованием специализированных СФ блоков.